

<input type="checkbox"/> Обозначение	Характеристика процесса	Применение, элементная база	PDF
<input type="checkbox"/> <u>200 В, с изоляцией р-п переходом 1 ПКК 1 металл, НДМОП/РДМОП высоковольтные транзисторы</u>	Кол-во фотолитографий, шт.	19	
	Средняя проектная норма, мкм	4.0	Аналоговые ИС малой степени интеграции с Ep до 210 В
	Подложка:	460КДБ12 [100]	
	Скрытые слои:	30КЭС5,5/300КДБ2.0	
	Эпитаксиальный слой	27КЭФ8.0	Вертикальный NPN:
	Изоляция:	р-п переход	Vp=70 Uce=50 В
	Глубина Р-кармана, мкм	6.5	НДМОП: Vtn= 2.0 В,
	Глубина базы НДМОП, мкм	3.0	Usd >200 В
	Подзатворный SiO <sub>2</sub> , Å	900	РДМОП: Vtp= -1.0 В,
	Глубина р-базы NPN, мкм	2.5	Usd >200 В
	Глубина N+эмиттера, мкм	0.8	NMOS: Vtn= 1.5 В , Usd >20 В
	Межслойный диэлектрик – СТФСС		
	0,55мкм+SIPOS 0.1мкм+ СТФСС 1,1мкм		Резисторы в слое:
	Длина канала по затвору:		База NPN, Р-сток, ПКК.
	N/РДМОП, мкм	6	
шаг ПКК, мкм	8	Емкости: ПКК-Si (SiO <sub>2</sub> 900 Å)	
контакты, мкм	ø 4	ПКК-Al (SiO <sub>2</sub> 1600 Å)	
шаг по металлу, мкм	12		

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

